# 北京工业大学 2010-2011 学年半导体物理期末试卷

## 一、 简答题(8\*6'=48')

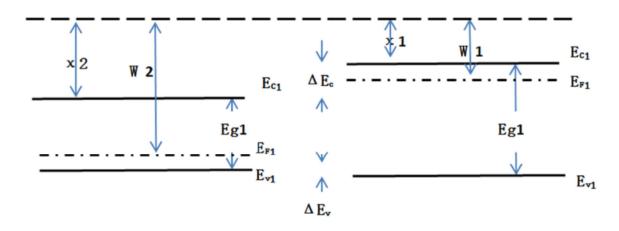
1. 请填写下表中的数据:

材料	晶格结构	布拉伐格子	直接/间接带隙	解理面
Si				
GaAs				

- 2. 什么是本征半导体?什么是杂质半导体?示意画出掺杂浓度为 Nd 的 N 型半导体样品电子浓度 n 和本征载流子浓度 ni 随 T 变化曲线。
- 3. "纯净的半导体中,掺入百万分之一的杂质,可以减小电阻率达1百万倍,"是估算说明之。
- 4. 一块杂志补偿的半导体,受主杂质和施主杂质浓度相等。设杂质全部电离,判断当杂质浓度分别为
  (a) Na=Nd=10<sup>14</sup>cm<sup>-3</sup> (b) Na=Nd=10<sup>18</sup>cm<sup>-3</sup> 时,哪种情况的电导率大?简述分析理由。
- 5. 什么是载流子的平均自由时间 τ ? 有两块 Si 半导体材料 1 和 2 , 其中τ1>τ2 , 迁移率哪个大 ? 如果同一块半导体中 , 有两种机理的平均自由时间τ1 和τ2 , 其总迁移率如何确定 ?
- 6. 写出以 n 型样品为例少子空穴的连续性方程。

由连续性方程写出:不考虑电场的作用、无产生、稳态载流子扩散方程;

- 7. 什么是 PN 结的势垒电容? 定性说明掺杂浓度对势垒电容有何影响。
- 一个 p-N 异质结接触前能带图见图 1。画出平衡状态下能带图。



**二、**(16')

电阻率为  $7\Omega$ ·cm 的 p 型硅 , T=300K。

- (1) 试计算室温时多数载流子和少子浓度(可查图)。
- (2) 计算该半导体的功函数。
- (3) 不考虑界面态,在金属铝(功函数 WAI=4.20eV)和金属铂(功函数 WPi=5.3eV)中选择制备肖特基二极管的金属,给出选择理由。
- (4) 求金属一侧势垒高度的理论值  $q\Phi_{ms}$  和半导体一侧势垒高度  $qV_D$  。

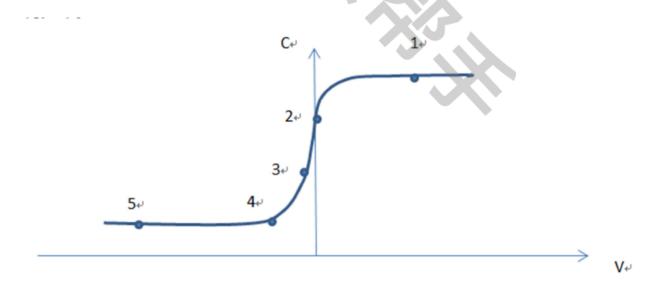
#### **三、** (16')

室温下,一个Si的N-P结,N区一侧掺杂浓度为1017cm-3,P区为1015cm-3

- (1) 求该 N-P 结的接触电势差。
- (2) 画出平衡 PN 结、正向偏置 PN 结、反向偏置 PN 结 空间电荷区中及边界处的载流子分布示意图。
- (3) 根据正向和反向少子分布情况,解释 PN 结正向导通,反向截止的饱和特性。
- (4) 写出理想 PN 结 电流-电压 关系公式,在对数坐标下,定性画出理想和实际 I-V 特性示意图。

### 四、 (15')

- 一理想的 MOS 结构的高频测量的 C-V 曲线如图 2.
- (1) 判断该结构中, 半导体的导电类型。
- (2)说明图中 1,2,3,4,5 点的半导体一侧的状态,并示意画出每点半导体一侧的能带形状,以及金属和半导体一侧的电荷分布。



# 五、 (5')

任意论述一种能够测量下列半导体参数的实验方法和测量原理:半导体掺杂浓度、多子迁移率、少子迁移率、PN结理想因子m。

## 附录:

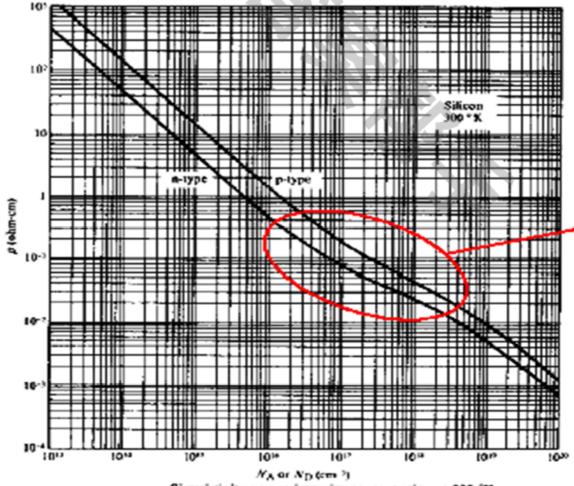
#### 1. 物理常数:

电子电荷	q	1.6x10 <sup>-19</sup> C
波尔兹曼常数	k	1.38x10 <sup>-23</sup> J/K
电子伏特	eV	1.6x10 <sup>-19</sup> J
真空介电常数	٤٥	8.854x10 <sup>-12</sup> F/m

### 2. Si 材料的性质 (300K):

本征载流子浓度	ni	1.5x10 <sup>10</sup> cm <sup>-3</sup>
导带底等效状态密度	Nc	3x10 <sup>10</sup> cm <sup>-3</sup>
价带顶等效状态密度	Nv	1x10 <sup>19</sup> cm <sup>-3</sup>
亲和势	X	4.05eV
禁带宽度	Eg	1.12 eV

### 3. Si 材料电阻率随掺杂浓度变化



Si resistivity versus impurity concentration at 300 °K.